プロトン照射したポリイミドフィルムの絶縁劣化特性の評価

内山龍*, 堀口皓平, 王振, 三宅弘晃, 田中康寛 (東京都市大学)

Evaluation for Insulation Degradation Properties in Proton Beam Irradiated Polyimide Films Ryo Uchiyama, Kohei Horiguchi, Shin Ou, Hiroaki Miyake, Yasuhiro Tanaka (Tokyo City University),

ABSTRACT

The spacecraft like a communication or a broadcasting satellite flying in GEO (Geostationary Orbit) is always exposed to plasma and/or radioactive-rays such as α -, β -, and γ -rays. When the insulating materials, in which the spacecraft is wrapped to keep temperature in it stable, are irradiated by the high energy proton beam, sometimes an unexpected accident due to an electrostatic discharge occurs. However, it has not known how the irradiation affects to change of the electrical properties of the materials. In our previous research work, we especially focused on an internal charging phenomenon which must affect to the electrical properties of irradiated polyimide for spacecraft. Judging from the measurement results, it is found that a positive charge accumulates in polyimide rapidly up to a certain saturated value, then it gradually decreases even during the proton beam irradiation. As the reason for the phenomenon, we consider the generation of RIC (Radiation Induced Conductivity). In this paper, we tried to measure the space charge distribution and conduction current under DC stress of 100 kV/mm in proton beam irradiated different type of Polyimides to figure out the mechanism of RIC.

キーワード:宇宙機,絶縁材料,プロトン照射,ポリイミド,空間電荷,導電率 (*Key words*: Spacecraft, Insulating material, Proton beam irradiation, Polyimide, Space charge, Conductivity)

1. はじめに

人工衛星などの宇宙機は、温度変化の激しい宇宙環境 において、機内の温度を一定に保つために、絶縁材料フ ィルムを積層した MLI (Multilayer Insulator)と呼ばれる熱 制御材料が使用されている。しかし、MLI は高エネルギ ー荷電粒子や放射線、プラズマ環境下などに曝されるこ とによって、帯電・放電現象が発生し、絶縁材料の劣化 や宇宙機に搭載されている機器の誤作動・故障を引き起 こすといわれている[1]-[2]。特に宇宙環境に起因する静 止衛星の事故のうち、過半数以上が帯電・放電現象が原 因であるという報告もなされていることから、宇宙機を 設計する際には、MLI などに使用される絶縁材料等の帯 電状況に影響を及ぼす。そのため、絶縁特性の評価が重 要となってくる。しかし、現在検討されている宇宙機設 計のガイドラインでは高エネルギー荷電粒子が照射され た絶縁フィルムの絶縁特性があまり考慮されていない。 そのため、宇宙環境に起因する事故を防ぐためにも、高 エネルギー荷電粒子が照射された高分子絶縁材料で生じ る帯電挙動を解析することが重要となっている。

これまで当研究グループでは、MLIとして実際に用い られるポリイミド高分子絶縁材料に着目し、パルス静電 応力法 (Pulsed Electro-acoustic Method: PEA 法)を用いた 内部帯電計測装置により、高エネルギープロトン照射中 における試料の内部帯電計測を行ってきた。その結果、 蓄積総電荷量がプロトン照射中に減少する傾向が確認さ れ、その原因としてプロトン照射による放射線誘起伝導 度(Radiation Induced Conductivity: RIC)が影響していると 考えた[3]。そこで本論文では PEA 法、および ASTM 法 (American Society for Testing and materials method)[4]を用 いてプロトンが照射されたポリイミドを用いて空間電荷 分布測定、導電率測定を行うことで、プロトン照射によ るポリイミドの絶縁劣化特性について調査していく。

2. 測定原理

<u>2-1. パルス静電応力法(PEA 法)の原理</u>

図1にPEA法の原理図を示す。電極で挟んだ試料にパル ス電界を印加することにより、空間電荷の存在する各位置 (厚み方向)で静電応力が瞬間的に発生し、試料に蓄積し ている電荷が微小変位する。これにより、圧力波が発生す る。圧力波は下部電極を伝搬してセンサー(圧電素子)に 到達し、電気信号に変換される。圧電素子から出力された 電圧信号を信号処理することによって空間電荷分布を得る。 なお、圧力波は試料内の電荷が蓄積するそれぞれの位置か ら発生するため、圧電素子に到達するまでに時間差が生じ る。これが出力信号の時間差として検出されるので、試料 内の空間電荷の位置情報を得ることができる。さらに、発 生する圧力波の振幅は電荷密度に比例するため、電荷密度 に比例した電気信号を得ることができる[5]-[6]。

<u>2-2. ASTM 法の原理</u>

図2にASTM法の原理図を示す。試料を電極で挟み、試料に直流電界を印加することにより、試料中を通過してきた漏れ電流I[A]が検出電極に出力される。出力された漏れ

電流をピコ・アンメーターで計測し、漏れ電流を電極面積 で除することで電流密度 J [A/m²]を求め、更に印加電界 E [V/m]で除することによって(1)式に示す導電率κ [S/m]を算 出することができる。

$$\kappa = J/E \tag{1}.$$



図 2 ASTM 法の測定原理 Fig. 2 Principle of the ASTM method

3. 測定試料および実験条件

図3に測定に使用した試料の分子構造を示す。測定試料 には、厚さ50µmの分子構造が異なる2種類のポリイミド フィルムを用いた。本論文では、それらの試料をPA(PI type A)とPB(PI type B)として表すことにする。



Fig. 3 Chemical structures of polyimide films

PEA 法、および ASTM 法を用いて直流電界下における未 照射・プロトン照射試料の空間電荷分布測定、伝導電流測 定を行った。照射したプロトンの加速エネルギーは1.0-2.5 MeV であり、電流密度を 30 nA/cm²一定として真空度 1.0× 10⁻⁵ Paの真空チャンバー内で 30 分間照射し、大気圧下にお いて約1日経過後に直流電界100kV/mmを印加し、その際 の試料内空間電荷分布測定、および電流密度の経時変化を 観測した。表1に加速エネルギー毎の試料名を示す。測定 結果では、表1の試料名を用いて解説を行う。測定時間は 空間電荷測定では印加 120 分、短絡 10 分の計 130 分間(測 定間隔10秒)行い、電流測定では印加180分間(測定間隔2.5 秒)行った。また、PA に関しては照射後の導電率の緩和過 程を調査するため、プロトンの加速エネルギー1.5, 2.0 MeV、 電流密度 30 nA/cm² お一定として真空チャンバー内で 30 分 間照射し、大気圧下において1-15日経過した試料に直流 電界 100 kV/mm を印加し、その際の電流密度の経時変化を 観測した。測定時間は印加120分間(測定間隔2.5秒)行った。 なお、プロトン照射には日本原子力研究開発機構高崎量子 応用研究所の 3MV タンデム加速器を用いて行った。

表1 加速エネルギー毎の試料名 Table.1 Naming table of the irradiated samples

Sample name	Material	Acceleration energy
PA0	PA	未照射
PA10		1.0 MeV
PA15		1.5 MeV
PA20		2.0 MeV
PA25		2.5 MeV
PB0	РВ	未照射
PB10		1.0 MeV
PB15		1.5 MeV
PB20		2.0 MeV
PB25		2.5 MeV

4. 実験結果および考察

<u>4-1. プロトン照射したポリイミドフィルムの直流高電界下</u> における空間電荷分布測定

図4,5に直流電界下におけるPA,PBの(1)空間電荷分布、 (2)電界分布波形、および空間電荷モデル図を示す。同図中 (a)には未照射試料を、(b) - (e)にはそれぞれ加速エネルギー 1.0 - 2.5 MeV のプロトン照射試料の測定結果である。図中 赤線,青線は印加開始10秒後、120分後、黒線は短絡10 分後をそれぞれ表している。また、同図(b) - (e)中の縦の破 線は SRIM によって算出したプロトンの最大飛程を示して いる[7]。加速エネルギー1.0,1.5 MeV の場合、プロトンの 飛程は19,37 µm であり、試料内に蓄積させる条件である。 加速エネルギー2.0,2.5 MeV の場合、プロトンの飛程は59, 84 µm であり、試料を十分に貫通している。







1) Space charge distribution 2) Electric field distribution



Fig.5 Space charge and electric field distributions in PB under DC average stress of 100 kV/mm

1) Space charge distribution 2) Electric field distribution

図 4(1-a)より、PA0 では電界印加による顕著な空間電荷 の蓄積は確認できない。また、電界分布も100 kV/mm 一定 である。図 4(1-b)より PA10 の場合、電界印加 10 秒後に微 量の正・負電荷の蓄積が見られ、印加 120 分後には最大飛 程、および陰極付近に正電荷、陽極に負電荷の蓄積がそれ ぞれ観測された。また、図 4(1-b)より、電界は1.3 倍の増加 が観測された。図 4(1-c)より PA15 の場合、印加開始直後に 最大飛程、および陽極付近に正・負電荷の蓄積が観測され た。また、図 4(1-c)より、電界は 1.5 倍の増加が観測された。 図 4(1-d)、(1-e)より PA25 では、印加開始直後に陰極付 近、および陽極付近に正・負電荷の蓄積が観測された。ま た、図 4(2-d)、(2-e)より、電界は 2.5 倍の増加が観測された。

次に図5(1-a)より、PB0では短絡10分後の測定結果より、 陰極、および陽極付近に微量の正・負電荷の蓄積が観測さ れた。これは、電界印加による電極からの注入電荷である と考えられる。図5(1-b),(1-c)より、PB10,PB15の場合、最 大飛程に正電荷の蓄積が観測された。また、陰極付近には 負電荷の蓄積が未照射領域に観測されていることから、負 電荷の蓄積は電極からの注入電荷であることがわかる。ま た、図5(2-b),(2-c)より、電界は1.2,1.1倍の増加が観測さ れた。一方、図5(1-d),(1-e)より、PB20,PB25では、未照射 試料同様、陰極、および陽極付近に正・負電荷の蓄積が見 られた。

<u>4-2. プロトン照射したポリイミドフィルムの直流高電界下</u> における伝導電流測定

図6,7に直流電界下における PA,PB の電流密度の経時変 化,導電率算出結果を示す。また、図7は図6における電 流密度の180分値を用いて算出した。図6(a)で加速エネル ギー1.5,2.0 MeV で照射した場合では電界印加中に絶縁破 壊が生じたため、導電率は絶縁破壊直前における電流密度 を用いた。なお、図6の縦軸は電流密度、横軸は時間を示 し、図7の縦軸は導電率、横軸はプロトンを照射した際の 加速エネルギーを表しており、加速エネルギー0 MeV 時の プロットは未照射試料における導電率を示している。また、 加速エネルギー毎の導電率の2-3個のプロットはそれぞれ の測定回数を示している。

図 6 (a)より、PA0 は電界印加直後に最大値に上昇後、その後印加時間の経過に伴い電流密度は 8.0 nA/m² まで減衰した。一方、プロトン照射試料では全ての照射条件において、電流量の増加が観測された。また PA15, PA20 では、電流密度はそれぞれ 1.0×10³, 1.0×10⁴ nA/m² まで減衰した後、電界印加 80, 30 分後に上昇を始め、2.0×10⁴, 2.0×10⁵ nA/m² に達した際に絶縁破壊に至った。また、図 7 より、未照射試料の導電率 1.0×10⁻¹⁶ S/m と比較すると、照射試料はそれぞれ 4.0×10⁻¹⁶, 2.0×10⁻¹³, 2.0×10⁻¹², 3.0×10⁻¹⁴ S/m であり約 4, 2000, 20000, 300 倍であった。したがって、導電率はプロトンの加速エネルギーに依存して増加したが、PA25 では、導



Fig. 7 The electrical conductivity in acceleration energy

電率の減少が見られた。これは,2.5 MeV では試料を十分 貫通させたことによる線エネルギー付与の影響であること が考えられる。一方、図6(b),図7よりPBの場合、プロト ン照射による電流密度、および導電率の顕著な変化は観測 されなかった。

これらの結果より、PAにおいては PAOとは異なり、電界 印加により、顕著な正・負の空間電荷分極が生じ、更に導 電率は最大104倍の上昇、および絶縁破壊が観測された。 一方、PB においてはプロトンを試料内に蓄積させた場合 では、正電荷の蓄積のみが試料内に観測され、貫通させた 場合では、未照射試料同様に顕著な空間電荷の蓄積は観測 されなかった。また、導電率も空間電荷蓄積同様、顕著な 変化は確認できなかった。このことから、同じポリイミド フィルムでも分子構造が異なることで、プロトン照射の影 響が異なると考えられる。PA においては照射前後で試料 内部の電気的特性が顕著に変化したと考えられる。高エネ ルギーのプロトンが分子鎖を切断することで、正・負のキ ャリアが多量に発生したまま材料内部に残留し、それが直 流高電界下で分離し、空間電荷分極が発生したと考えられ る。また、この分極電荷は電界印加直後から発生しており、 試料内の導電率も高くなっていると予想でき、電流計測に よる導電率の結果からも、それが裏付けられていることが わかる。したがって、PA に関しては、プロトン照射によ り、絶縁特性が劣化していると言える。一方、PB に関し ては、図5(2-d), (2-e)より、プロトン照射によるキャリア の生成がない、あるいは極めて少ないと考えられることか ら、空間電荷蓄積、および導電率に変化が観測されなかっ たと考えられる。

<u>4-3. プロトン照射したポリイミドフィルムの照射後における導電率の経時変化</u>

高分子絶縁材料に荷電粒子照射後において、導電率が上 昇する現象として遅延放射線誘起伝導(Delayed Radiation Induced Conductivity: DRIC)が挙げられる。しかし、その現 象は照射後の経過時間によって減少することが報告されて いる[8]-[9]。そこで、プロトン照射後の経過時間と導電率の 関係を調査するため、プロトン照射後における導電率の経 時変化を観測した。図 8,9に未照射試料、および加速エネ ルギー1.5,2.0 MeV のプロトンを照射し、大気圧下において 1-15 日経過した PA の直流電界下における電流密度の経時 変化,および導電率算出結果を示す。また、図9は図8に おける電流密度の120分値を用いて算出した。図8で照射 後1 日経過した試料の場合では電界印加中に絶縁破壊が生 じたため、導電率は絶縁破壊直前における電流密度を用い た。

図 8(a)より PA15 の場合、照射後1,2,6,15 日経過することで電界印加による電流密度の上昇は減少した。また、電界印加中における電流密度の上昇、および絶縁破壊は照射

後1 日経過した試料でのみ観測された。図8(b)よりPA20 もPA15 同様、照射後1,2,3,5,15 日経過することで電界印 加による電流密度の上昇は減少した。また、電界印加中に おける電流密度の上昇、および絶縁破壊は照射後1 日経過 した試料でのみ観測された。また、図9より照射試料の導 電率はPA15の場合、4.0×10⁻¹³,2.0×10⁻¹⁵,5.0×10⁻¹⁶,3.0×10⁻¹⁶ S/m、PA20の場合、4.0×10⁻¹⁶,6.0×10⁻¹⁵,1.0×10⁻¹⁵,6.0×10⁻¹⁶ 3.0×10⁻¹⁶ S/m であり、照射試料の導電率は照射後の時間経 過によって、未照射試料の導電率1.6×10⁻¹⁶ S/m まで減衰す ることが確認された。

以上より、PAのプロトン照射による導電率の上昇は時間 経過に依存して減衰したことから、絶縁劣化特性は照射後 の時間経過により、絶縁特性が回復することがわかった。



Fig. 9 Time dependence of the electrical conductivity

5. まとめ

異なる分子構造を持つポリイミドフィルムを用いてプロ トン照射実験を行った結果、プロトン照射による空間電荷 蓄積特性、および RIC の影響が異なることがわかった。ま た、プロトン照射による RIC の影響は、空間電荷分布測定、 および導電率測定から、高エネルギーのプロトン照射によ って生じたキャリアの発生が影響していることがわかった。 また、PA の RIC の増加は照射後の時間経過に依存して減少 することがわかった。

6. 今後の予定

PA, PB におけるキャリア生成の有無、導電率の上昇を試 料の分子構造の観点から解析を行っていく。

謝辞

本研究は科学研究費補助金(No. 23760292)、及び日本原子 力研究開発機構の施設供用制度により実施された。

文 献

- [1] C. Koons, J. E. Mazur, R. S. Selesnick, J. B. Blake, J. F. Fennell, J. L. Roeder and P. C. Anderson, "The Impact of the Space Environment on Space Systems", Proceedings of the 6th Spacecraft Charging Technology Conference, Air Force Research Laboratory, pp. 7-11, 1998.
- [2] D. Payan, R. Reulet, B. Dirassen, "Electrostatic behavior of dielectrics under GEO-like charging space environment simulated in laboratory", 9th Spacecraft Charging Technology Conferrence, Proceeding, Tsukuba (Japan), 4-9 April 2005.
- [3] Yang, G.M.; Sessler, G.M., "Radiation-induced conductivity in electron-beam irradiated insulating polymer films" Electrical Insulation, IEEE Transactions on, Vol. 27, Issue 4, pp.843-848, 1992
- [4] Metrology of volume resistivity and solid electric insulating material-surface resistivity: JIS C 2139 and 2008
- [5] Y.Li, M. Yasuda and T. Takada.: "Pulsed Electroacoustic Method for Measurement of Charge Accumulation in Solid Dielectrics", Transactions on DEI, Vol.1, No.2, pp.188-195, 1994.
- [6] T. Takada, H. Miyake, and Y. Tanaka, "Pulse Acoustic Technology for Measurement of Charge Distribution in Dielectric Materials for Spacecraft", IEEE NPSC Transactions on Plasma Science, Vol. 34, No. 5, pp.2176-2184, 2006
- [7] J. F. Ziegler, J. P. Biersack and U. Littmark, "The Stopping and Range of Ions in Solids", Pergamon Press, New York, 1985
- [8] L. Levy, T. Paulmier, B. Dirassen, C. Inguimbert, and M. V. Eesbeek, "Aging and Prompt Effects on Space Material Properties", IEEE Transactions on Plasma Science, Vol. 36, No.5, pp.2228-2237, 2008.
- [9] N. W. Green and J. R. Dennison, "Deep Dielectric Charging of Spacecraft Polymers by Energetic Protons", IEEE

Transactions on Plasma Science, Vol. 36, No.5, pp.2482-2490, 2008.